

D4SBS4

40V 4A

特長

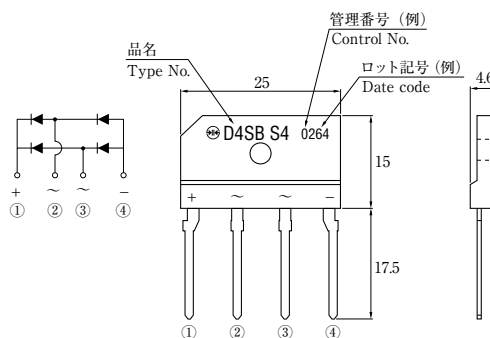
- 薄型 SIP パッケージ
- SBD ブリッジ
- 低 V_F

Feature

- Thin-SIP
- SBD Bridge
- Low V_F

■外観図 OUTLINE

Package : 3S

Unit : mm
Weight : 3.9g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

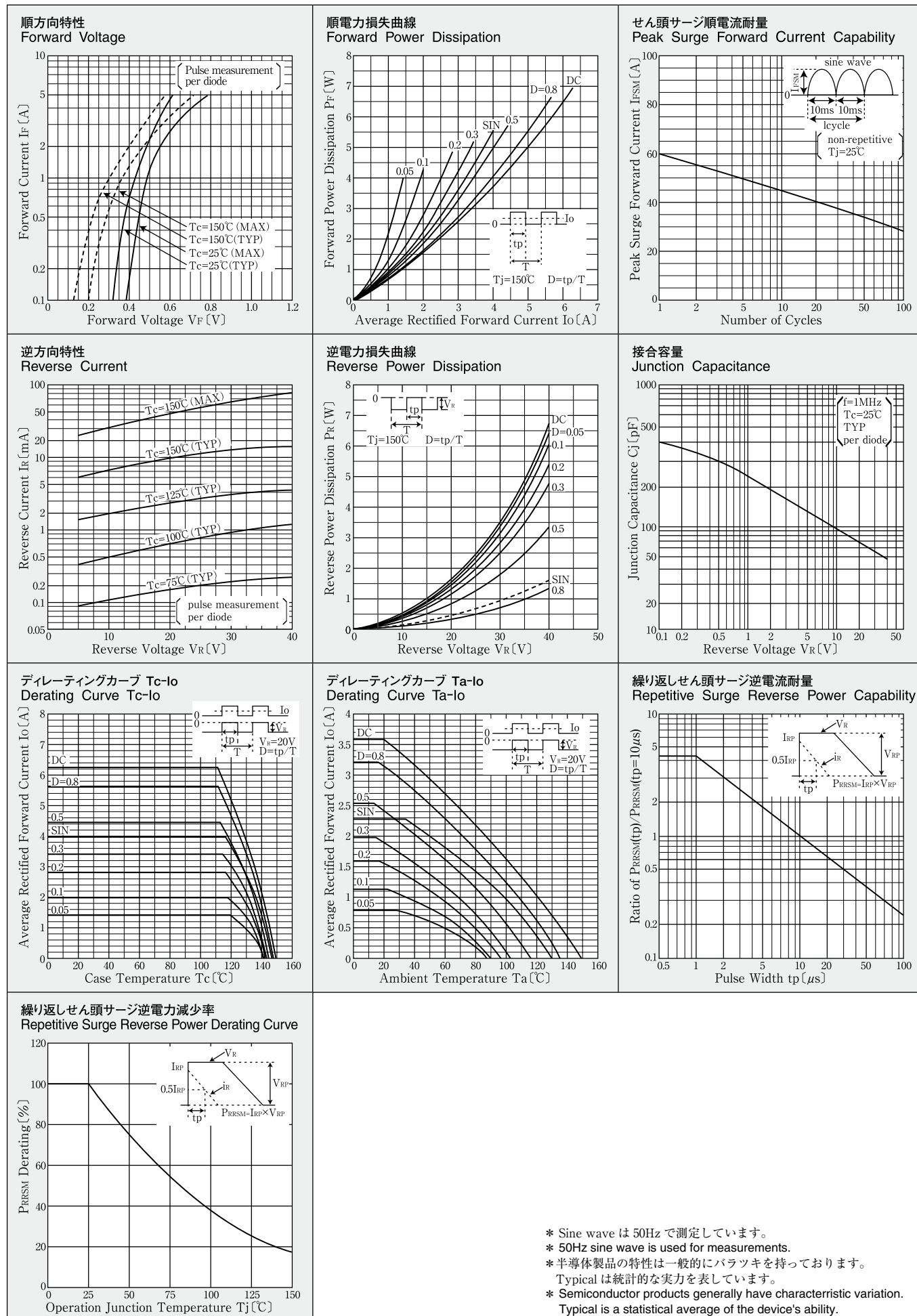
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_C=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D4SBS4	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55~150	$^{\circ}\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^{\circ}\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			40	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Voltage	V_{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		45	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink $T_C=116^{\circ}\text{C}$	4	A
			フィンなし Without heatsink $T_a=33^{\circ}\text{C}$	2.3	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j=25^{\circ}\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j=25^{\circ}\text{C}$		60	A
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	P_{RRSM}	パルス幅10 μs , 1 素子当たり, $T_j=25^{\circ}\text{C}$ Pulse width 10 μs , per diode, $T_j=25^{\circ}\text{C}$		160	W
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V_{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.5 N・m) (Recommended torque: 0.5 N・m)		0.8	N・m

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_C=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F=2\text{A}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 0.55	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R=V_{RM}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 2	mA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f=1\text{MHz}$, $V_R=10\text{V}$, 1 素子当たりの規格値 per diode	TYP 95	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 5.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
	θ_{jl}	接合部・リード間, フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 6	
	θ_{ja}	接合部・周囲間, フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 40	

特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
- * Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
- * Typical is a statistical average of the device's ability.